

单晶硅热中子全截面的测量

@张南宁\$中国原子能科学研究院!北京 @陈桂英\$中国原子能科学研究院!北京 @阮景辉\$中国原子能科学研究院!北京

收稿日期 1984-3-29 修回日期 网络版发布日期:

摘要 <正> 一、前言 从反应堆水平孔道出来的热中子束,伴随着强的 γ 射线和快中子,这些 γ 射线和快中子是各种谱仪的本底计数和工作场所的辐射剂量的主要来源,为此,常采用晶体过滤器等加以控制和消除。而决定晶体材料过滤特性的主要参数是晶体的全截面。对于单晶硅,最早由Brugger测定了25,50和70 meV三个能量点的全截面,并拟合成一条能量从几

关键词 [单晶硅](#) [全截面](#) [热中子](#) [过滤器](#)

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(241KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“单晶硅”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者